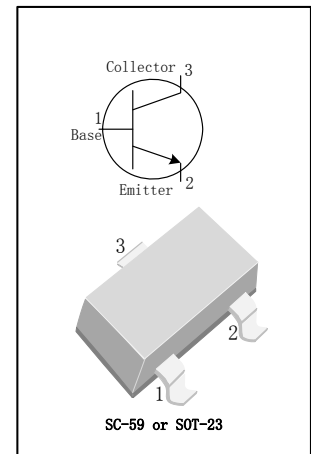


2SC3583NPN TRANSISTOR (NPN)

MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER

NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR



简述:

- 具有高功率增益放大以及低噪声特性，大动态范围，理想的电流线性；
- 主要应用于超高频微波无线射频放大、VHF、UHF 和 CATV 高频宽带低噪声放大器等电路中；
- 集电极-基极击穿电压: $BV_{CBO} \geq 20V$, 集电极电流: $I_C \geq 65mA$, 集电极功率: $P_C \geq 200mW$ (SOT-323 封装 $P_C \geq 150mW$)，特征频率: $f_T = 9GHz$;
- 可替代进口同类型号参数的高频微波低噪声晶体管；
- 封装形式: SC-59 (SOT-23-3L)、SOT-23。

极限参数 ($T_{amb}=25^\circ C$) :

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	20	V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	9	V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	3	V
集电极电流	I_C	65	mA
耗散功率	P_T	200(SC-59、SOT-23), 150(SOT-323)	mW
最高结温	T_J	150	$^\circ C$
储存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	$^\circ C$

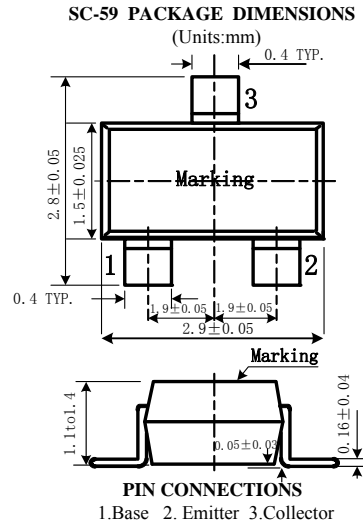
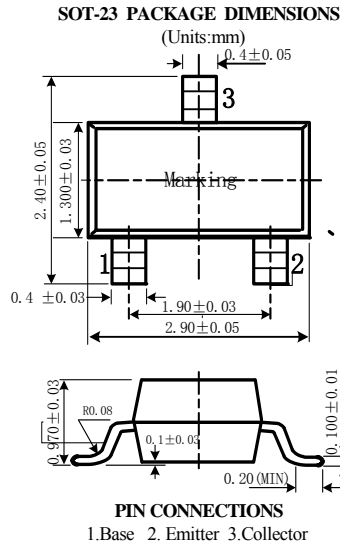
电参数及规格 ($T_{amb}=25^\circ C$) :

参数名称	符号	测试条件	额定值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=10\mu A, I_E=0 mA$	20	-	-	V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=1.0mA, I_B=0 mA$	9	-	-	V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=10\mu A, I_C=0 mA$	3	-	-	V
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=10V, I_E=0 mA$	-	-	0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=1.0V, I_C=0 mA$	-	-	1.0	μA
直流电流放大系数	h_{FE}	$V_{CE}=8V, I_C=20mA$	50	120	250	
特征频率	f_T	$V_{CE}=8V, I_C=20mA$	-	9	-	GHz
反馈电容	C_{re}	$I_E=0 mA, V_{CB}=8V, f=1MHz$	-	0.35	1.0	pF
插入功率增益	$ S_{21e} ^2$	$I_C=20mA, V_{CE}=8V, f=1GHz$	-	13	-	dB
可用增益	MAG	$I_C=20mA, V_{CE}=8V, f=1GHz$	-	15	-	dB
噪声系数	NF	$V_{CE}=8V, I_C=7mA, f=1GHz$	-	1.2	2.0	dB

CLASSIFICATION OF h_{FE}

Range	50 ~ 100	80 ~ 150	125 ~ 250
Marking	R33	R34	R35

各封装形式外形尺寸



包装信息 PACKAGE INFORMATION

Package	Shipping	Inner Box	Carton
SC-59	3000pcs/Tape&Reel	5 Tape&Reel	12 Inner Box
SOT-23	3000pcs/Tape&Reel	10 Tape&Reel	6 Inner Box